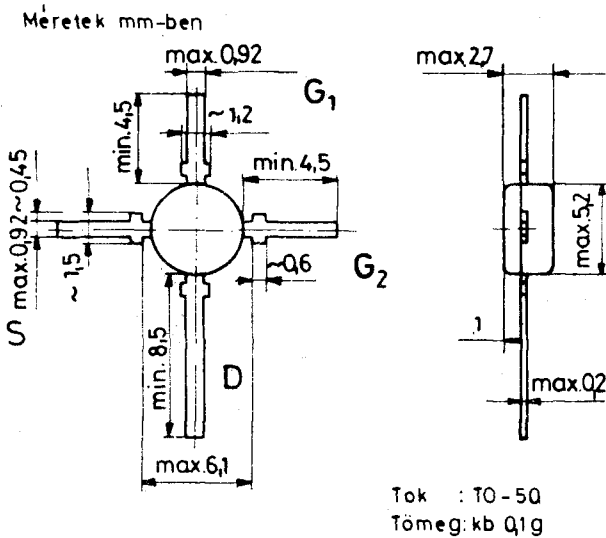


# M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fótl út 56.

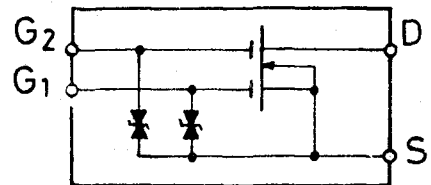
1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

## BF 964 N-csatornás két Gate-es MOS térhatású kiűritéses módú tetroda



Ajánlott alkalmazás  
VHF hangoló egység bemenő és keverő fokozatában.

Jellegzetes tulajdonságok:  
Gate-et védő diódák beépítve.  
Nagy keresztmoduláció-feldolgozás.  
Alacsony zajtényező.  
Nagy AGC átfogási tartomány.  
Kicsi visszaható kapacitás.  
Kicsi bemenő kapacitás.



MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	BF 964	EGYSÉG
Drain-Source feszültség	$V_{DS}$	20	V
Drain áram	$I_D$	30	mA
1-es és 2-es Gate által vezérelt Source áram csúcserő	$\pm I_G$ 1/2 SM	10	mA
Teljes teljesítménydisszipáció $T_{amb}=60^\circ C$	$P_{tot}$	200	mW
Csatorna hőmérséklet	$T_C$	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	$T_{stg}$	- 55... +150	$^\circ C$
<b>HŐELLENÁLLÁS</b>			
csatorna és környezet között	$R_{thCA}$	450	K/W
40x25x1,5mm egy oldalán 35 $\mu m$ Cu fóliás nyomtatott áramköri lapra szerelve			

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ha másként nincs megadva	JELÖLÉS	BF 964	EGYSÉG
Drain-Source letörési feszültség $I_D=10\ \mu\text{A}$ , $-V_{G1S}=-V_{G2S}=4\text{V}$	$V_{(BR)DS}$	$\geq 20$	V
1-es Gate és Source közötti letörési feszültség $\pm I_{G2S}=10\text{mA}$ , $V_{G2S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G1SS}$	$\geq 6$	V
2-es Gate és Source közötti letörési feszültség $\pm I_{G2S}=10\text{mA}$ , $V_{G1S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G2SS}$	$\geq 6$	V
1-es Gate – Source visszáram $\pm V_{G1S}=5\text{V}$ , $V_{G2S}=V_{DS}=0$	$I_{G1SS}$	$\leq 50$	nA
2-es Gate – Source visszáram $V_{G2S}=5\text{V}$ , $V_{G1S}=V_{DS}=0$	$I_{G2SS}$	$\leq 50$	nA
Drain áram $V_{DS}=15\text{V}$ , $V_{G1S}=0$ , $V_{G2S}=4\text{V}$	$I_{DSS}$	$\geq 2$ $\leq 20$	mA
1-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15\text{V}$ , $V_{G2S}=4\text{V}$ , $I_D=20\ \mu\text{A}$	$-V_{G1S(OFF)}$	$\leq 2,5$	V
2-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15\text{V}$ , $V_{G1S}=0$ , $I_D=20\ \mu\text{A}$	$-V_{G2S(OFF)}$	$\leq 2,0$	V

DINAMIKUS JELLEMZŐK $V_{DS}=15\text{V}$ , $I_D=10\text{mA}$ , $V_{G2S}=4\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ha másként nincs megadva	JELÖLÉS	BF 964	EGYSÉG
Meredekség	$Y_{fs}$	$\geq 15$ 17	mS
1-es Gate bemenő kapacitás	$C_{iSSg1}$	2,5; $\leq 3,0$	pF
2-es Gate bemenő kapacitás $V_{G1S}=0$ , $V_{G2S}=4\text{V}$	$C_{iSSg2}$	1,2	pF
Visszaható kapacitás (G és S földelve)	$C_{rSS}$	25; $\leq 35$	pF
Kimenő kapacitás	$C_{oSS}$	1,0; $\leq 1,3$	pF
Teljesítmény erősítés $V_{DS}=15\text{V}$ , $I_D=10\text{mA}$ , $V_{G2S}=4\text{V}$ $g_G=2\text{mS}$ , $g_L=0,5\text{mS}$ , $f=200\text{MHz}$	$G_{ps}$	25	dB
Zajtényező $V_{DS}=15\text{V}$ , $I_D=10\text{mA}$ , $V_{G2S}=4\text{V}$ $g_G=2\text{mS}$ , $f=200\text{MHz}$	F	1,0	dB

Schronk László

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).



**M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT**